(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号 特開2001-172565 (P2001-172565A)

(43)公開日 平成13年6月26日(2001.6.26)

(51) Int.Cl. ⁷	識別記号	FΙ	テーマコード(参考)
C 0 9 D 183/00		C 0 9 D 183/00	4J038
171/02		171/02	5F058
H 0 1 L 21/312		H 0 1 I. 21/312	C

審査請求 未請求 請求項の数9 OL (全 13 頁)

(21)出願番号	特顯平 11-360291	(71)出願人	000004178
			ジェイエスアール株式会社
(22)出顧日	平成11年12月20日(1999.12.20)		東京都中央区築地2丁目11番24号
		(72)発明者	杉浦 誠
			東京都中央区築地二丁目11番24号ジェイエ
			スアール株式会社内
		(72)発明者	篠田 智隆
			東京都中央区築地二丁目11番24号ジェイエ
		:	スアール株式会社内
		(72)発明者	川井 淳可
			東京都中央区築地二丁目11番24号ジェイエ
			スアール株式会社内
			具数百に始く
			最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 膜形成用組成物および絶縁膜形成用材料

(57)【要約】

【課題】 半導体素子などにおける層間絶縁膜材料として、塗膜の機械的特性やクラック耐性、溶液の保存安定性に優れ、かつ低い比誘電率を示す膜形成用組成物を得る。

【解決手段】

(A) (A-1)下記一般式(1)で

 $(R^3, R^4, R^5$ および R^6 は、同一でも異なっていてもよく、それぞれ1価の有機基を示し、bおよびcは、同一でも異なっていてもよく、 $0\sim2$ の数を示し、 R^7 は酸素原子または $-(CH_2)_n$ ーで表される基を示し、nは $1\sim6$ を、dは0または1を示す。)からなる群より選ばれる少なくとも1種の化合物を上記(A-1)成分

表される化合物および

 $R^{1}_{a}Si(OR^{2})_{4-a} \cdot \cdot \cdot \cdot (1)$

 $(R^1$ は水素原子、フッ素原子または1価の有機基を示し、 R^2 は1価の有機基を示し、aは $0\sim2$ の整数を表す。)(A-2)下記一般式(2)で表される化合物

 R^{3}_{b} (R⁴O) _{3-b} S i - (R⁷) _d-S i (OR⁵) _{3-c} R⁶_c · · · (2)

および (A-2) 成分中のアルコキシル基1モルに対して0.0001 \sim 0.001モルの有機酸と上記 (A-1) 成分おおよび (A-2) 成分中のアルコキシル基1モルに対して0.8 \sim 2.5モルの水との存在下で加水分解し、縮合した加水分解縮合物ならびに (B) 有機溶媒を含有することを特徴とする膜形成用組成物。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 (A) (A-1)下記一般式 (1) で表 される化合物および

 $R^{1}aSi$ (OR²) 4-a · · · · · (1)

 R^{3}_{b} (R⁴O) _{3-b} S i - (R⁷) _d-S i (OR⁵) _{3-c} R⁶_c · · · (2)

(R3, R4, R5およびR6は、同一でも異なっていても よく、それぞれ1価の有機基を示し、bおよびcは、同 一でも異なっていてもよく、0~2の数を示し、R7は 酸素原子または-(CH2)n-で表される基を示し、n 選ばれる少なくとも1種の化合物を上記(A-1)成分 および(A-2)成分中のアルコキシル基1モルに対し て0.00001~0.001モルの有機酸と上記(A -1)成分おおよび (A-2)成分中のアルコキシル基 1モルに対して0.8~2.5モルの水との存在下で加 水分解し、縮合した加水分解縮合物ならびに(B)有機 溶媒を含有することを特徴とする膜形成用組成物。

【請求項2】 ポリアルキレンオキサイド構造を有する 化合物、フッ素系界面活性剤、シリコーン系界面活性剤 から選ばれる少なくとも1種をさらに含有することを特 20 徴とする請求項1記載の膜形成用組成物。

【請求項3】 (B)成分がプロピレングリコールモノ アルキルエーテルが、プロピレングリコールモノメチル エーテル、プロピレングリコールモノエチルエーテル、 プロピレングリコールモノプロピルエーテル、プロピレ ングリコールモノイソプロピルエーテル、プロピレング リコールモノブチルエーテルから選ばれる少なくとも1 種であることを特徴とする請求項1記載の膜形成用組成 物。

【請求項4】 ポリアルキレンオキシド構造を有する化 30 合物が、ポリメチレンオキサイド構造、ポリエチレンオ キサイド構造、ポリプロピレンオキサイド構造、ポリテ トラメチレンオキサイド構造、ポリブチレンオキサイド 構造から選ばれる少なくとも1種であることを特徴とす る請求項2記載の膜形成用組成物。

【請求項5】 有機酸がカルボキシル基を含有する化合 物であることを特徴とする請求項1記載の膜形成用組成 物。

【請求項6】 (A-1)成分および(A-2)成分か らなる群より選ばれる少なくとも1種の化合物が下記ー 40 殷式 (3)で表される化合物および下記一般式 (4)で 表される化合物からなることを特徴とする請求項1記載 の膜形成用組成物。

 $Si(OR^2)_4 \cdot \cdot \cdot \cdot (3)$

(R2は、1価の有機基を示す。)

 $R^{1}_{n}Si(OR^{2})_{4-n} \cdot \cdot \cdot \cdot (4)$

(R1は水素原子、フッ素原子または1価の有機基を示 し、R2は1価の有機基を示し、nは1~2の整数を表

※メトキシシラン、テトラエトキシシランから選ばれる少 なくとも1種であり、一般式(4)で表される化合物が メチルトリメトキシシラン、メチルトリエトキシシラ ン、ジメチルジメトキシシラン、ジメチルジエトキシシ は $1\sim6$ を、dは0または1を示す。) からなる群より 10 ランであることを特徴とする請求項6記載の膜形成用組

*(R1は水素原子、フッ素原子または1価の有機基を示

し、R2は1価の有機基を示し、aは0~2の整数を表

す。) (A-2) 下記一般式 (2) で表される化合物

【請求項8】 一般式(3)で表される化合物と一般式 (4)で表される化合物の使用割合が、一般式 (4)で 表される化合物100重量部(完全加水分解縮合物換 算)に対して、一般式(3)で表される化合物の含有量 が5~60重量部であることを特徴とする請求項6記載 の膜形成用組成物。

【請求項9】 請求項1~8記載の膜形成用組成物から なることを特徴とする絶縁膜形成用材料。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、膜形成用組成物に 関し、さらに詳しくは、半導体素子などにおける層間絶 縁膜材料として、塗膜の機械的特性やクラック耐性、溶 液の保存安定性に優れ、かつ低い比誘電率を示す膜形成 用組成物および絶縁膜形成用材料に関する。

[0002]

【従来の技術】従来、半導体素子などにおける層間絶縁 膜として、CVD法などの真空プロセスで以て形成され たシリカ (SiO2) 膜が多用されている。 そして、 近 年、より均一な層間絶縁膜を形成することを目的とし て、SOG (Spin on Glass) 膜と呼ばれ るテトラアルコキシランの加水分解生成物を主成分とす る塗布型の絶縁膜も使用されるようになっている。ま た、半導体素子などの高集積化に伴い、有機SOGと呼 ばれるポリオルガノシロキサンを主成分とする低比誘電 率の層間絶縁膜が開発されている。しかしながら、半導 体素子などのさらなる高集積化や多層化に伴い、より優 れた導体間の電気絶縁性が要求されており、したがっ て、より低比誘電率で機械的強度に優れる層間絶縁膜材 料が求められるようになっている。

【0003】そこで、特開平6-181201号公報に は、層間絶縁膜材料として、より低比誘電率の絶縁膜形 成用塗布型組成物が開示されている。この塗布型組成物 は、吸水性が低く、耐クラック性に優れた半導体装置の 絶縁膜を提供することを目的としており、その構成は、 チタン、ジルコニウム、ニオブおよびタンタルから選ば れる少なくとも1種の元素を含む有機金属化合物と、分 子内にアルコキシ基を少なくとも1個有する有機ケイ素 【請求項7】 一般式(3)で表される化合物がテトラ※50 化合物とを縮重合させてなる、数平均分子量が500以 上のオリゴマーを主成分とする絶縁膜形成用塗布型組成物である。

【0004】また、WO96/00758号公報には、 多層配線基板の層間絶縁膜の形成に使用される、アルコ キシシラン類、シラン以外の金属アルコキシドおよび有 機溶媒などからなる、厚膜塗布が可能で、かつ耐酸素プ ラズマ性に優れるシリカ系塗布型絶縁膜形成用材料が開 示されている。

【0005】さらに、特開平3-20377号公報には、電子部品などの表面平坦化、層間絶縁などに有用な 10酸化物被膜形成用塗布液が開示されている。この酸化物被膜形成用塗布液は、ゲル状物の発生のない均一な塗布液を提供し、また、この塗布液を用いることにより、高温での硬化、酸素プラズマによる処理を行った場合であっても、クラックのない良好な酸化物被膜を得ることを目的としている。そして、その構成は、所定のシラン化合物と、同じく所定のキレート化合物とを有機溶媒の存在化で加水分解し、重合して得られる酸化物被膜形成用塗布液である。 *

$$R^{3}_{b}$$
 ($R^{4}O$) _{3-b} S i - (R^{7}) ₄-S i (OR^{5}) _{3-c} R^{6}_{c} · · · · · (2)

(R³, R⁴, R⁵およびR⁶は、同一でも異なっていても ** よく、それぞれ1価の有機基を示し、bおよびcは、同一でも異なっていてもよく、0~2の数を示し、R⁻は 酸素原子または一(CH2)n一で表される基を示し、n は1~6を、dは0または1を示す。)からなる群より 選ばれる少なくとも1種の化合物を上記(A-1)成分および(A-2)成分中のアルコキシル基1モルに対して0.00001~0.001モルの有機酸と上記(A-1)成分おおよび(A-2)成分中のアルコキシル基 301モルに対して0.8~2.5モルの水の存在下で加水分解し、縮合した加水分解縮合物ならびに(B)有機溶 媒を含有することを特徴とする膜形成用組成物および絶縁膜形成用材料を提供するものである。

[0009]

【発明の実施の形態】(A)成分

(A-1)成分

上記一般式(1)において、R¹およびR²の1価の有機基としては、アルキル基、アリール基、アリル基、グリシジル基などを挙げることができる。また、一般式(1)において、R¹は1価の有機基、特にアルキル基またはフェニル基であることが好ましい。ここで、アルキル基としては、メチル基、エチル基、プロピル基、ブチル基などが挙げられ、好ましくは炭素数1~5であり、これらのアルキル基は貸状でも、分岐していてもよく、さらに水素原子がフッ素原子などに置換されていてもよい。一般式(1)において、アリール基としては、フェニル基、ナフチル基、メチルフェニル基、エチルフェニル基、クロロフェニル基、ブロモフェニル基、フルオロフェニル基などを挙げることができる。

*【0006】しかし、上記のようにシラン化合物にチタンやジルコニウムなどの金属キレート化合物を組み合せた場合、塗膜の機械的特性やクラック耐性、溶液の保存安定性、塗膜の低い比誘電率などをバランスよく有するものではない。

[0007]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、上記問題点を解決するための膜形成用組成物に関し、さらに詳しくは、半導体素子などにおける層間絶縁膜として、塗膜の機械的特性やクラック耐性、溶液の保存安定性に優れ、低い比誘電率示す層間絶縁膜用材料を提供することを目的とする。

【0008】本発明は、(A) (A-1)下記一般式(1)で表される化合物

 $R^{1}aSi$ (OR²) 4-a · · · · · (1)

 $(R^1$ は水素原子、フッ素原子または1 価の有機基を示し、 R^2 は1 価の有機基を示し、aは0 \sim 2 の整数を表す。) および (A-2) 下記一般式 (2) で表される化合物

※【0010】一般式(1)で表される化合物の具体例と **〟しては、トリメトキシシラン、トリエトキシシラン、ト** リーn-プロポキシシラン、トリーiso-プロポキシ シラン、トリーnーブトキシシラン、トリーsecーブ トキシシラン、トリーtertーブトキシシラン、トリ フェノキシシラン、フルオロトリメトキシシラン、フル オロトリエトキシシラン、フルオロトリーロープロポキ シシラン、フルオロトリーisoープロポキシシラン、 フルオロトリーnーブトキシシラン、フルオロトリーs ecーブトキシシラン、フルオロトリーtertーブト キシシラン、フルオロトリフェノキシシラン、テトラメ トキシシラン、テトラエトキシシラン、テトラーnープ ロポキシシラン、テトラーisoープロポキシシラン、 テトラーnーブトキシラン、テトラーsecーブトキシ シラン、テトラーtertーブトキシシラン、テトラフ ェノキシシランなど; メチルトリメトキシシラン、メチ ルトリエトキシシラン、メチルトリーnープロポキシシ ラン、メチルトリーisoープロポキシシラン、メチル 40 トリーnーブトキシシラン、メチルトリーsecーブト キシシラン、メチルトリーtertーブトキシシラン、 メチルトリフェノキシシラン、エチルトリメトキシシラ ン、エチルトリエトキシシラン、エチルトリーnープロ ポキシシラン、エチルトリーiso-プロポキシシラ ン、エチルトリーnーブトキシシラン、エチルトリーs ecーブトキシシラン、エチルトリーtertーブトキ シシラン、エチルトリフェノキシシラン、ビニルトリメ トキシシラン、ビニルトリエトキシシラン、ビニルトリ ーnープロポキシシラン、ビニルトリーisoープロポ **※50** キシシラン、ビニルトリーnーブトキシシラン、ビニル

トリーsecーブトキシシラン、ビニルトリーtert ープトキシシラン、ビニルトリフェノキシシラン、nー プロピルトリメトキシシラン、nープロピルトリエトキ シシラン、nープロピルトリーnープロポキシシラン、 n-プロピルトリーiso-プロポキシシラン、n-プ ロピルトリーnーブトキシシラン、nープロピルトリー secーブトキシシラン、nープロピルトリーtert ーブトキシシラン、nープロピルトリフェノキシシラ ン、i-プロピルトリメトキシシラン、i-プロピルト リエトキシシラン、i-プロピルトリーn-プロポキシ 10 シラン、iープロピルトリーisoープロポキシシラ ン、iープロピルトリーnーブトキシシラン、iープロ ピルトリーsecーブトキシシラン、iープロピルトリ ーtertーブトキシシラン、i-プロピルトリフェノ キシシラン、nーブチルトリメトキシシラン、nーブチ ルトリエトキシシラン、nーブチルトリーnープロポキ シシラン、nーブチルトリーisoープロポキシシラ ン、nーブチルトリーnーブトキシシラン、nーブチル トリーsecーブトキシシラン、nーブチルトリーte rt-ブトキシシラン、n-ブチルトリフェノキシシラ 20 ン、sec-ブチルトリメトキシシラン、sec-ブチ ルーiートリエトキシシラン、secーブチルートリー nープロポキシシラン、secーブチルートリーiso ープロポキシシラン、secーブチルートリーnーブト キシシラン、secーブチルートリーsecーブトキシ シラン、secーブチルートリーtertーブトキシシ ラン、secーブチルートリフェノキシシラン、tーブ " チルトリメトキシシラン、t ープチルトリエトキシシラ ン、セーブチルトリーnープロポキシシラン、セーブチ ルトリーiso-プロポキシシラン、tーブチルトリー n-ブトキシシラン、t-ブチルトリーsec-ブトキ シシラン、セーブチルトリーセertーブトキシシラ ン、tーブチルトリフェノキシシラン、フェニルトリメ トキシシラン、フェニルトリエトキシシラン、フェニル トリーnープロポキシシラン、フェニルトリーiso-プロポキシシラン、フェニルトリーnーブトキシシラ ン、フェニルトリーsecーブトキシシラン、フェニル トリーtertーブトキシシラン、フェニルトリフェノ キシシラン、ビニルトリメトキシシラン、ビニルトリエ トキシシラン、ケーアミノプロピルトリメトキシシラ ン、ケーアミノプロピルトリエトキシシラン、ケーグリ シドキシプロピルトリメトキシシラン、アーグリシドキ シプロピルトリエトキシシラン、アートリフロロプロピ ルトリメトキシシラン、アートリフロロプロピルトリエ トキシシランなど;ジメチルジメトキシシラン、ジメチ ルジエトキシシラン、ジメチルージーnープロポキシシ ラン、ジメチルージーisoープロポキシシラン、ジメ チルージーnーブトキシシラン、ジメチルージーsec ーブトキシシラン、ジメチルージーtertーブトキシ

キシシラン、ジエチルジエトキシシラン、ジエチルージ -n-プロポキシシラン、ジエチルージーiso-プロ ポキシシラン、ジエチルージーnーブトキシシラン、ジ エチルージーsecーブトキシシラン、ジエチルージー tert-ブトキシシラン、ジエチルジフェノキシシラ ン、ジーnープロピルジメトキシシラン、ジーnープロ ピルジエトキシシラン、ジーnープロピルージーnープ ロポキシシラン、ジーnープロピルージーisoープロ ポキシシラン、ジーnープロピルージーnーブトキシシ ラン、ジー n ープロピルージー s e c ーブトキシシラ ン、ジーnープロピルージーtertーブトキシシラ ン、ジーnープロピルージーフェノキシシラン、ジーi soープロピルジメトキシシラン、ジーisoープロピ ルジエトキシシラン、ジーiso-プロピルージーn-プロポキシシラン、ジーisoープロピルージーiso ープロポキシシラン、ジーisoープロピルージーn-ブトキシシラン、ジーiso-プロピルージーsec-ブトキシシラン、ジーiso-プロピルージーtert ープトキシシラン、ジーiso-プロピルージーフェノ キシシラン、ジーnーブチルジメトキシシラン、ジーn ープチルジエトキシシラン、ジーn-ブチルージ-n-プロポキシシラン、ジーnーブチルージーisoープロ ポキシシラン、ジーnーブチルージーnーブトキシシラ ン、ジーnーブチルージーsecーブトキシシラン、ジ -n-ブチルージーtert-ブトキシシラン、ジーn ープチルージーフェノキシシラン、ジーsecーブチル ジメトキシシラン、ジーsecーブチルジエトキシシラ ン、ジーsecーブチルージーnープロポキシシラン、 ジーsecーブチルージーiso-プロポキシシラン、 30 $\vec{y} - \mathbf{s} \in \mathbf{c} - \vec{y} + \mathbf{h} - \vec{y} - \mathbf{n} - \vec{y} + \mathbf{h} + \hat{y} + \hat{y}$ ecーブチルージーsecーブトキシシラン、ジーse cーブチルージーtertーブトキシシラン、ジーse cーブチルージーフェノキシシラン、ジーtertーブ チルジメトキシシラン、ジーtertーブチルジエトキ シシラン、ジーtertーブチルージーnープロポキシ シラン、ジーtertーブチルージーisoープロポキ シシラン、ジーtertーブチルージーnーブトキシシ ラン、ジーtert-ブチルージ-sec-ブトキシシ ラン、ジーtertーブチルージーtertーブトキシ 40 シラン、ジーtertーブチルージーフェノキシシラ ン、ジフェニルジメトキシシラン、ジフェニルージーエ トキシシラン、ジフェニルージーnープロポキシシラ ン、ジフェニルージーisoープロポキシシラン、ジフ ェニルージーnーブトキシシラン、ジフェニルージーs ecーブトキシシラン、ジフェニルージーtertーブ トキシシラン、ジフェニルジフェノキシシラン、ジビニ ルトリメトキシシラン、アーアミノプロピルトリメトキ シシラン、アーアミノプロピルトリエトキシシラン、ア ーグリシドキシプロピルトリメトキシシラン、アーグリ シラン、ジメチルジフェノキシシラン、ジエチルジメト 50 シドキシプロピルトリエトキシシラン、ケートリフロロ

プロピルトリメトキシシラン、アートリフロロプロピル トリエトキシシランなど;を挙げることができる。好ま しくは、テトラメトキシシラン、テトラエトキシシラ ン、テトラーnープロポキシシラン、テトラーiso-プロポキシシラン、テトラフェノキシシラン、メチルト リメトキシシラン、メチルトリエトキシシラン、メチル トリーnープロポキシシラン、メチルトリーisoープ ロポキシシラン、エチルトリメトキシシラン、エチルト リエトキシシラン、ビニルトリメトキシシラン、ビニル トリエトキシシラン、フェニルトリメトキシシラン、フ 10 3ーテトラフェニルジシロキサン、1,3ージエトキシ ェニルトリエトキシシラン、ジメチルジメトキシシラ ン、ジメチルジエトキシシラン、ジエチルジメトキシシ ラン、ジエチルジエトキシシラン、ジフェニルジメトキ シシラン、ジフェニルジェトキシシラン、トリメチルモ ノメトキシシラン、トリメチルモノエトキシシラン、ト リエチルモノメトキシシラン、トリエチルモノエトキシ シラン、トリフェニルモノメトキシシラン、トリフェニ ルモノエトキシシランであり、特に好ましくはテトラメ トキシシラン、テトラエトキシシラン、メチルトリメト キシシラン、メチルトリエトキシシラン、ジメチルジメ 20 2,2-テトラメトキシ-1,2-ジメチルジシラン、 トキシシラン、ジメチルジエトキシシランである。これ らは、1種あるいは2種以上を同時に使用してもよい。 【0011】(A-2)成分

上記一般式(2)において、1価の有機基としては、先 の一般式(1)と同様な有機基を挙げることができる。 また、一般式(2)のR7である2価の有機基として は、メチレン基、炭素数2~6のアルキレン基などを挙 げることができる。一般式(2)のうち、R7が酸素原 子の化合物としては、ヘキサメトキシジシロキサン、ヘ キサエトキシジシロキサン、ヘキサフェノキシジシロキ 30 サン、1, 1, 1, 3, 3-ペンタメトキシー3-メチ ルジシロキサン、1, 1, 1, 3, 3-ペンタエトキシ -3-メチルジシロキサン、1, 1, 1, 3, 3-ペン タメトキシー3ーフェニルジシロキサン、1,1,1, 3, 3-ペンタエトキシー3-フェニルジシロキサン、 1, 1, 3, 3-7シロキサン、1, 1, 3, 3-テトラエトキシー1, 3 ージメチルジシロキサン、1,1,3,3ーテトラメト キシー1, 3-ジフェニルジシロキサン、1, 1, 3、 3-テトラエトキシ-1, 3-ジフェニルジシロキサ ン、1, 1, 3-トリメトキシ-1, 3, 3-トリメチ ルジシロキサン、1, 1, 3-トリエトキシ-1, 3,3-トリメチルジシロキサン、1,1,3-トリメトキ シ-1, 3, 3-トリフェニルジシロキサン、1, 1, 3ートリエトキシー1,3,3ートリフェニルジシロキ サン、1, 3-ジメトキシ-1, 1, 3, 3-テトラメ チルジシロキサン、1, 3-ジエトキシ-1, 1, 3,3-テトラメチルジシロキサン、1,3-ジメトキシー 1, 1, 3, 3-テトラフェニルジシロキサン、1, 3 ージエトキシー1, 1, 3, 3ーテトラフェニルジシロ 50 ル) エタン、ビス (エトキシジメチルシリル) エタン、

R キサンなどを挙げることができる。これらのうち、ヘキ サメトキシジシロキサン、ヘキサエトキシジシロキサ ン、1, 1, 3, 3ーテトラメトキシー1, 3ージメチ ルジシロキサン、1, 1, 3, 3-テトラエトキシー 1, 3-ジメチルジシロキサン、1, 1, 3, 3-テト ラメトキシー1, 3-ジフェニルジシロキサン、1, 3 ージメトキシー1, 1, 3, 3ーテトラメチルジシロキ サン、1, 3-ジエトキシ-1, 1, 3, 3-テトラメ チルジシロキサン、1,3-ジメトキシ-1,1,3, -1, 1, 3, 3-テトラフェニルジシロキサンなど を、好ましい例として挙げることができる。一般式 (2) において dが 0 の 化合物としては、 ヘキサメトキ シジシラン、ヘキサエトキシジシラン、ヘキサフェニキ シジシラン、1,1,1,2,2-ペンタメトキシー2 ーメチルジシラン、1,1,1,2,2-ペンタエトキ シー2-メチルジシラン、1, 1, 1, 2, 2-ペンタ メトキシー2-フェニルジシラン、1,1,1,2,2 ーペンタエトキシー2ーフェニルジシラン、1,1, 1, 1, 2, 2-テトラエトキシー1, 2-ジメチルジ シラン、1,1,2,2-テトラメトキシ-1,2-ジ フェニルジシラン、1,1,2,2-テトラエトキシー 1, 2-ジフェニルジシラン、1, 1, 2-トリメトキ シー1, 2, 2ートリメチルジシラン、1, 1, 2ート リエトキシー1,2,2ートリメチルジシラン、1. 1,2-トリメトキシー1,2,2-トリフェニルジシ **ラン、1, 1, 2ートリエトキシー1, 2, 2ートリフ** ェニルジシラン、1,2-ジメトキシ-1,1,2,2 ーテトラメチルジシラン、1,2-ジエトキシー1, 1, 2, 2-テトラメチルジシラン、1, 2-ジメトキ シ-1, 1, 2, 2-テトラフェニルジシラン、1, 2 ージエトキシー1, 1, 2, 2ーテトラフェニルジシラ ンなどを、一般式 (2) において R7が - (CH2) n -で表される基の化合物としては、ビス(ヘキサメトキシ シリル) メタン、ビス (ヘキサエトキシシリル) メタ ン、ビス (ヘキサフェノキシシリル) メタン、ビス (ジ メトキシメチルシリル) メタン、ビス (ジエトキシメチ ルシリル) メタン、ビス (ジメトキシフェニルシリル) 40 メタン、ビス (ジエトキシフェニルシリル) メタン、ビ ス (メトキシジメチルシリル) メタン、 ビス (エトキシ ジメチルシリル) メタン、 ビス (メトキシジフェニルシ リル) メタン、ビス (エトキシジフェニルシリル) メタ ン、ビス (ヘキサメトキシシリル) エタン、ビス (ヘキ サエトキシシリル) エタン、ビス (ヘキサフェノキシシ リル) エタン、ビス (ジメトキシメチルシリル) エタ ン、 ビス (ジエトキシメチルシリル) エタン、 ビス (ジ メトキシフェニルシリル) エタン、ビス (ジエトキシフ ェニルシリル) エタン、ビス (メトキシジメチルシリ

ビス (メトキシジフェニルシリル) エタン、ビス (エト キシジフェニルシリル) エタン、1,3-ビス (ヘキサ メトキシシリル) プロパン、1、3-ビス (ヘキサエト キシシリル) プロパン、1,3-ビス (ヘキサフェノキ シシリル) プロパン、1,3-ビス (ジメトキシメチル シリル) プロパン、1,3-ビス (ジエトキシメチルシ リル) プロパン、1,3-ビス (ジメトキシフェニルシ リル) プロパン、1,3-ビス (ジエトキシフェニルシ リル) プロパン、1、3ービス (メトキシジメチルシリ ル) プロパン、1,3-ビス (エトキシジメチルシリ ル) プロパン、1,3-ビス (メトキシジフェニルシリ ル) プロパン、1,3-ビス (エトキシジフェニルシリ ル) プロパンなどを挙げることができる。 これらのう ち、ヘキサメトキシジシラン、ヘキサエトキシジシラ ン、 $^{+}$ ラメトキシー1, 2-ジメチルジシラン、1, 1, 2, 2-テトラエトキシー1, 2-ジメチルジシラン、1, 1, 2, 2-テトラメトキシ-1, 2-ジフェニルジシ 92, 1, 1, 2, 2-7, 9ェニルジシラン、1, 2-ジメトキシ-1, 1, 2, 2 20 -FF1, 2, 2-テトラメチルジシラン、1, 2-ジメトキ シ-1, 1, 2, 2-テトラフェニルジシラン、1, 2 ージエトキシー1, 1, 2, 2ーテトラフェニルジシラ ン、ビス (ヘキサメトキシシリル) メタン、ビス (ヘキ サエトキシシリル) メタン、ビス (ジメトキシメチルシ リル) メタン、ビス (ジエトキシメチルシリル) メタ ン、 ビス (ジメトキシフェニルシリル) メタン、 ビス (ジエトキシフェニルシリル) メタン、ビス (メトキシ ジメチルシリル) メタン、ビス (エトキシジメチルシリ 30 ン、エチルベンゼン、トリメチルベンゼン、メチルエチ ル) メタン、ビス (メトキシジフェニルシリル) メタ ン、ビス (エトキシジフェニルシリル) メタンを、好ま しい例として挙げることができる。本発明において、 (A-1)成分および(A-2)成分としては、上記 (A-1)成分および(A-2)成分、もしくはいずれ か一方を用い、(A-1)成分および(A-2)成分は それぞれ2種以上用いることもできる。 【0012】本発明において、(A-1)成分および (A-2)成分からなる群より選ばれる少なくとも1種

記一般式(4)で表される化合物からなることが特に好 ましい。

 $Si(OR^2)_4 \cdot \cdot \cdot \cdot (3)$

(R²は、1価の有機基を示す。)

 $R^{1}_{n}Si(OR^{2})_{4-n} \cdot \cdot \cdot \cdot (4)$

(R1は水素原子、フッ素原子または1価の有機基を示 し、R2は1価の有機基を示し、nは1~2の整数を表 す。) さらに一般式(3)で表される化合物がテトラメ トキシシラン、テトラエトキシシランから選ばれる少な くとも1種であり、一般式(4)で表される化合物がメ 50 エチルエーテル、エチレングリコールモノーn-ブチル

チルトリメトキシシラン、メチルトリエトキシシラン、 ジメチルジメトキシシラン、ジメチルジエトキシシラン であることが好ましい。一般式(3)で表される化合物 と一般式(4)で表される化合物の使用割合は、一般式 (4)で表される化合物100重量部 (完全加水分解縮 合物換算) に対して、一般式(3)で表される化合物の 含有量が5~60重量部である。

10

【0013】本発明において、加水分解とは、上記(A -1) 成分および (A-2) 成分に含まれるR²O-

10 基、R4O-基、およびR5O-基すべてが加水分解され ている必要はなく、例えば1個だけが加水分解されてい るもの、2個以上が加水分解されているもの、あるい は、これらの混合物が生成することである。本発明にお いて縮合とは(A-1)成分および(A-2)成分の加 水分解物のシラノール基が縮合してSi-O-Si結合 を形成したものであるが、本発明では、シラノール基が すべて縮合している必要はなく、僅かな一部のシラノー ル基が縮合したもの、縮合の程度が異なっているものの 混合物などをも生成することを包含した概念である。

【0014】本発明において、(A)成分は(A-1) 成分および(A-2)成分を溶剤に溶解し、有機酸触媒 と水の存在下で (A-1) 成分および (A-2) 成分の 加水分解を行うにことより製造する。

【0015】本発明に使用することのできる有機溶剤と しては、例えば、nーペンタン、iーペンタン、nーへ キサン、i ーヘキサン、nーヘプタン、i ーヘプタン、 ⁻2,2,4-トリメチルペンタン、n-オクタン、i-オクタン、シクロヘキサン、メチルシクロヘキサンなど の脂肪族炭化水素系溶媒; ベンゼン、トルエン、キシレ ルベンゼン、nープロピルベンセン、iープロピルベン セン、ジエチルベンゼン、iーブチルベンゼン、トリエ チルベンゼン、ジーi-プロピルベンセン、n-アミル ナフタレン、トリメチルベンゼンなどの芳香族炭化水素 系溶媒;アセトン、メチルエチルケトン、メチルー n-プロピルケトン、メチルーnーブチルケトン、ジエチル ケトン、メチルーiーブチルケトン、メチルーnーペン チルケトン、エチルーnーブチルケトン、メチルーnー ヘキシルケトン、ジー i ーブチルケトン、トリメチルノ の化合物が下記一般式(3)で表される化合物および下 40 ナノン、シクロヘキサノン、2-ヘキサノン、メチルシ クロヘキサノン、2,4-ペンタンジオン、アセトニル アセトン、ジアセトンアルコール、アセトフェノン、フ ェンチョンなどのケトン系溶媒;エチルエーテル、i-プロピルエーテル、nーブチルエーテル、nーヘキシル エーテル、2-エチルヘキシルエーテル、エチレンオキ シド、1,2-プロピレンオキシド、ジオキソラン、4 ーメチルジオキソラン、ジオキサン、ジメチルジオキサ ン、エチレングリコールモノメチルエーテル、エチレン グリコールモノエチルエーテル、エチレングリコールジ

エーテル、エチレングリコールモノーnーヘキシルエー テル、エチレングリコールモノフェニルエーテル、エチ レングリコールモノー2-エチルブチルエーテル、エチ レングリコールジブチルエーテル、ジエチレングリコー ルモノメチルエーテル、ジエチレングリコールモノエチ ルエーテル、ジエチレングリコールジエチルエーテル、 ジエチレングリコールモノーnーブチルエーテル、ジエ チレングリコールジー n ープチルエーテル、ジエチレン グリコールモノーnーヘキシルエーテル、エトキシトリ グリコール、テトラエチレングリコールジーnーブチル 10 る。これらのうちではプロピレングリコールモノアルキ エーテル、トリプロピレングリコールモノメチルエーテ ル、テトラヒドロフラン、2-メチルテトラヒドロフラ ン、プロピレングリコールモノアルキルエーテルとして は、プロピレングリコールモノメチルエーテル、プロピ レングリコールモノエチルエーテル、プロピレングリコ ールモノプロピルエーテル、プロピレングリコールモノ イソプロピルエーテル、プロピレングリコールモノブチ ルエーテル、プロピレングリコールジメチルエーテル、 プロピレングリコールジエチルエーテル、プロピレング リコールジプロピルエーテル、プロピレングリコールジ 20 ブチルエーテル、ジプロピレングリコールモノメチルエ ーテル、ジプロピレングリコールモノエチルエーテル、 ジプロピレングリコールモノプロピルエーテル、ジプロ ピレングリコールモノブチルエーテル、ジプロピレング リコールジメチルエーテル、ジプロピレングリコールジ エチルエーテル、ジプロピレングリコールジプロピルエ ーテル、ジプロピレングリコールジブチルエーテルなど のエーテル系溶媒;ジエチルカーボネート、酢酸メチ ル、酢酸エチル、アーブチロラクトン、アーバレロラク トン、酢酸nープロピル、酢酸iープロピル、酢酸nー ブチル、酢酸iーブチル、酢酸secーブチル、酢酸n ーペンチル、酢酸secーペンチル、酢酸3-メトキシ ブチル、酢酸メチルペンチル、酢酸2-エチルブチル、 酢酸2-エチルヘキシル、酢酸ベンジル、酢酸シクロヘ キシル、酢酸メチルシクロヘキシル、酢酸n-ノニル、 アセト酢酸メチル、アセト酢酸エチル、酢酸エチレング リコールモノメチルエーテル、酢酸エチレングリコール モノエチルエーテル、酢酸ジエチレングリコールモノメ チルエーテル、酢酸ジエチレングリコールモノエチルエ ーテル、酢酸ジエチレングリコールモノ-n-ブチルエ 40 V(A-2) 成分中のアルコキシル基1モルに対して ーテル、酢酸プロピレングリコールモノメチルエーテ ル、酢酸プロピレングリコールモノエチルエーテル、酢 酸プロピレングリコールモノプロピルエーテル、酢酸プ ロピレングリコールモノブチルエーテル、酢酸ジプロピ レングリコールモノメチルエーテル、酢酸ジプロピレン グリコールモノエチルエーテル、ジ酢酸グリコール、酢 酸メトキシトリグリコール、プロピオン酸エチル、プロ ピオン酸nーブチル、プロピオン酸iーアミル、シュウ 酸ジエチル、シュウ酸ジーn-ブチル、乳酸メチル、乳 酸エチル、乳酸n-ブチル、乳酸n-アミル、マロン酸 50

ジエチル、フタル酸ジメチル、フタル酸ジエチルなどの エステル系溶媒; N-メチルホルムアミド、N, N-ジ メチルホルムアミド、N, N-ジエチルホルムアミド、 アセトアミド、N-メチルアセトアミド、N, N-ジメ チルアセトアミド、N-メチルプロピオンアミド、N-メチルピロリドンなどの含窒素系溶媒; 硫化ジメチル、 硫化ジエチル、チオフェン、テトラヒドロチオフェン、 ジメチルスルホキシド、スルホラン、1,3-プロパン スルトンなどの含硫黄系溶媒などを挙げることができ ルエーテルとしては、プロピレングリコールモノメチル エーテル、プロピレングリコールモノエチルエーテル、 プロピレングリコールモノプロピルエーテル、プロピレ ングリコールモノイソプロピルエーテル、プロピレング リコールモノブチルエーテルを挙げることができ、特に 好ましくはプロピレングリコールモノメチルエーテル、 プロピレングリコールモノエチルエーテル、プロピレン グリコールモノプロピルエーテルなどが好ましい。有機

溶媒は(A-1)成分および(A-2)成分の合計量1

00重量部に対して、通常100~5000重量部、好

ましくは120~4000重量部使用する。

【0016】本発明において使用する有機酸としては、 例えば酢酸、プロピオン酸、ブタン酸、ペンタン酸、ヘ キサン酸、ヘプタン酸、オクタン酸、ノナン酸、デカン 酸、シュウ酸、マレイン酸、メチルマロン酸、アジピン 酸、セバシン酸、没食子酸、酪酸、メリット酸、アラキ ドン酸、ミキミ酸、2-エチルヘキサン酸、オレイン 酸、ステアリン酸、リノール酸、リノレイン酸、サリチ ル酸、安息香酸、pーアミノ安息香酸、pートルエンス 30 ルホン酸、ベンゼンスルホン酸、モノクロロ酢酸、ジク ロロ酢酸、トリクロロ酢酸、トリフルオロ酢酸、ギ酸、 マロン酸、スルホン酸、フタル酸、フマル酸、クエン 酸、酒石酸、無水マレイン酸の加水分解物、無水フタル 酸の加水分解物等を挙げることができる。これらの中 で、カルボキシル基を有する化合物が好ましく、酢酸、 シュウ酸、マレイン酸、ギ酸、マロン酸、無水マレイン 酸の加水分解物が特に好ましい。これらは1種あるいは 2種以上を同時に使用しても良い。

【0017】有機酸の使用割合は、(A-1)成分およ 0.00001~0.001モルが好ましく、0.00 001~0.0009モルが特に好ましい。有機酸の使 用割合が0.00001モル未満であると、塗膜の塗布 性に劣り、0.001モルを超えると塗膜のクラック耐 性が低下することがある。また、有機酸は、前記溶剤中 に予め添加しておいてもよいし、水添加時に水中に溶解 あるいは分散させておいてもよい。

【0018】上記 (A-1) 成分および (A-2) 成分 を加水分解、縮合させる際に、(A-1)成分および (A-2) 成分中のアルコキシル基1モルに対して0.

8~2.5モルの水を用いることが好ましく、0.8~ 物、デンドリマー、ポリイミド、ポリアミック酸、ポリアリーレン、ポリアミド、ポリキノキサリン、ポリオキサが0.8モル未満であると塗膜のクラック耐性が劣 サジアゾール、フッ素系重合体、ボリアルキレンオキサイド構造を有する化合物などを挙げることができる。 【0021】ポリアルキレンオキサイド構造を有する化ることが好ましい。本発明において、(A-1)成分および(A-2)成分を加水分解するときの温度は通常0~100℃、好ましくは15~80℃である。なお、(A)成分の加水分解縮合物の重量平均分子量は、通常、700~10,000、好ましくは700~8,0 10 7レンアルキルフェニルエーシの程度である。

【0019】(B)成分

本発明の膜形成用組成物は(A)成分である加水分解縮 合物と有機溶媒となからる。ここで使用できる有機溶媒 としては、前記(A)成分の合成時に使用した有機溶媒 と同様のものを上げることができるが、特に好ましくは プロピレングリコールモノアルキルエーテルである。プ ロピレングリコールモノアルキルエーテルとしては、プ ロピレングリコールモノメチルエーテル、プロピレング リコールモノエチルエーテル、プロピレングリコールモ 20 ノプロピルエーテル、プロピレングリコールモノイソプ ロピルエーテル、プロピレングリコールモノブチルエー テルを挙げることができ、特に好ましくはプロピレング リコールモノメチルエーテル、プロピレングリコールモ ノエチルエーテル、プロピレングリコールモノプロピル エーテルである。これらは1種あるいは2種以上を同時 に使用しても良い。本発明において、(A)成分の合成 時に溶剤として(B)成分を使用した場合には、反応液 をそのまま使用することができるが、(B)成分以外の 溶剤を使用した場合には、溶剤の50重量%以上が(B) 30 成分となるように溶剤を置換する必要がある。

【0020】本発明の膜形成用組成物は、さらに下記のような成分を含有してもよい。

その他の添加剤

本発明で得られる膜形成用組成物には、さらにコロイド状シリカ、コロイド状アルミナ、有機ポリマー、界面活性剤などの成分を添加してもよい。コロイド状シリカとは、例えば、高純度の無水ケイ酸を前記親水性有機溶媒に分散した分散液であり、通常、平均粒径が5~30mμ、好ましくは10~20mμ、固形分濃度が10~4400重量%程度のものである。このような、コロイド状シリカとしては、例えば、日産化学工業(株)製、メタノールシリカゾルおよびイソプロパノールシリカゾル;触媒化成工業(株)製、オスカルなどが挙げられる。コロイド状アルミナとしては、日産化学工業(株)製のアルミナゾル520、同100、同200;川研ファインケミカル(株)製のアルミナクリアーゾル、アルミナゾル10、同132などが挙げられる。有機ポリマーとしては、例えば、糖鎖構造を有する化合物、ビニルアミド系重合体、(メタ)アクリル系重合体、苦毒体ビニル化会50

物、デンドリマー、ポリイミド,ポリアミック酸、ポリ アリーレン、ポリアミド、ポリキノキサリン、ポリオキ サジアゾール、フッ素系重合体、ポリアルキレンオキサ イド構造を有する化合物などを挙げることができる。 【0021】ポリアルキレンオキサイド構造を有する化 合物としては、ポリメチレンオキサイド構造、ポリエチ レンオキサイド構造、ポリプロピレンオキサイド構造、 ポリテトラメチレンオキサイド構造、ポリブチレンオキ シド構造などが挙げられる。具体的には、ポリオキシメ エーテル、ポリオキシエテチレンアルキルフェニルエー テル、ポリオキシエチレンステロールエーテル、ポリオ キシエチレンラノリン誘導体、アルキルフェノールホル マリン縮合物の酸化エチレン誘導体、ポリオキシエチレ ンポリオキシプロピレンブロックコポリマー、ポリオキ シエチレンポリオキシプロピレンアルキルエーテルなど のエーテル型化合物、ポリオキシエチレングリセリン脂 肪酸エステル、ポリオキシエチレンソルビタン脂肪酸エ ステル、ポリオキシエチレンソルビトール脂肪酸エステ ル、ポリオキシエチレン脂肪酸アルカノールアミド硫酸 塩などのエーテルエステル型化合物、ポリエチレングリ コール脂肪酸エステル、エチレングリコール脂肪酸エス テル、脂肪酸モノグリセリド、ポリグリセリン脂肪酸エ ステル、ソルビタン脂肪酸エステル、プロピレングリコ ール脂肪酸エステル、ショ糖脂肪酸エステルなどのエー : テルエステル型化合物などを挙げることができる。 ポリ オキシチレンポリオキシプロピレンブロックコポリマー としては下記のようなブロック構造を有する化合物が挙

14

0 - (A) n - (B) m -

げられる。

-(A) n - (B) m - (A) 1 -

(式中、AはーCH₂CH₂Oーで表される基を、BはーCH₂CH (CH₃) Oーで表される基を示し、nは1~90、mは10~99、1は0~90の数を示す)これらの中で、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンブロックコポリマー、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンアルキルエーテル、ポリオキシエチレンソルビタン脂肪酸エステル、ポリオキシエチレンソルビトール脂肪酸エステル、ポリオキシエチレンソルビトール脂肪酸エステル、などのエーテル型化合物をより好ましい例として挙げることができる。これらは1種あるいは2種以上を同時に使用しても良い。

媒化成工業(株)製、オスカルなどが挙げられる。コロ イド状アルミナとしては、日産化学工業(株)製のアル ミナゾル520、同100、同200;川研ファインケ ミカル(株)製のアルミナクリアーゾル、アルミナゾル 10、同132などが挙げられる。有機ポリマーとして は、例えば、糖鎖構造を有する化合物、ビニルアミド系 重合体、(メタ)アクリル系重合体、芳香族ビニル化合 50 素系界面活性剤、シリコーン系界面活性剤を挙げること ができる。

【0023】フッ素系界面活性剤としては、例えば1, 1, 2, 2-テトラフロロオクチル(1, 1, 2, 2-テトラフロロプロピル) エーテル、1, 1, 2, 2-テ トラフロロオクチルヘキシルエーテル、オクタエチレン グリコールジ(1,1,2,2-テトラフロロブチル) エーテル、ヘキサエチレングリコール(1,1,2, 2, 3, 3-ヘキサフロロペンチル) エーテル、オクタ プロピレングリコールジ(1,1,2,2-テトラフロ ロブチル) エーテル、ヘキサプロピレングリコールジ (1, 1, 2, 2, 3, 3-ヘキサフロロペンチル) エ ーテル、パーフロロドデシルスルホン酸ナトリウム、 1, 1, 2, 2, 8, 8, 9, 9, 10, 10ーデカフ ロロドデカン、1, 1, 2, 2, 3, 3-ヘキサフロロ デカン、N-[3-(パーフルオロオクタンスルホンア ミド) プロピル]-N, N 'ージメチル-N-カルボキ シメチレンアンモニウムベタイン、パーフルオロアルキ ルスルホンアミドプロピルトリメチルアンモニウム塩、 パーフルオロアルキルーN-エチルスルホニルグリシン 塩、リン酸ビス (N-パーフルオロオクチルスルホニル 20 -N-エチルアミノエチル)、モノパーフルオロアルキ ルエチルリン酸エステル等の末端、主鎖および側鎖の少 なくとも何れかの部位にフルオロアルキルまたはフルオ*

*ロアルキレン基を有する化合物からなるフッ素系界面活 性剤を挙げることができる。また、市販品としてはメガ ファックF142D、同F172、同F173、同F1 83 (以上、大日本インキ化学工業 (株) 製)、エフト ップEF301、同303、同352 (新秋田化成 (株)製)、フロラードFC-430、同FC-431 (住友スリーエム (株) 製)、アサヒガードAG71 0、サーフロンS-382、同SC-101、同SC-102、同SC-103、同SC-104、同SC-1 05、同SC-106(旭硝子(株)製)、BM-10 00、BM-1100(裕商(株)製)、NBX-15 ((株)ネオス)などの名称で市販されているフッ素系 界面活性剤を挙げることができる。これらの中でも、上 記メガファックF172, BM-1000, BM-11 00, NBX-15が特に好ましい。

16

【0024】シリコーン系界面活性剤としては、例えば SH7PA、SH21PA、SH30PA、ST94P A (いずれも東レ・ダウコーニング・シリコーン (株) 製などを用いることが出来る。これらの中でも、上記S H28PA、SH30PAに相当する下記一般式(6) で表される重合体が特に好ましい。

[0025]

ルオロアルキルまたはフルオ* 【化1】
$$CH_3$$
 CH_3 CH_4 CH_5 CH_5 CH_5 CH_6 CH_7 CH_8 CH_8

(式中、R12は水素原子または炭素数1~5のアルキ ル基であり、nは1~20の整数であり、x、yはそれ ぞれ独立に2~100の整数である。)

界面活性剤の使用量は、(A)成分(完全加水分解縮合 物) 100重量部に対して通常0.0001~10重量 部である。

【0026】本発明において、膜形成用組成物中の沸点 100℃以下のアルコールの含量が、20重量%以下、 特に5重量%以下であることが好ましい。沸点100℃ 以下のアルコールは、上記(A-1)成分ならびに(A 40 レート、オーブン、ファーネスなどを使用することが出 -2)成分の加水分解および/またはその縮合の際に生 じる場合があり、その含量が20重量%以下、好ましく は5重量%以下になるように蒸留などにより除去するこ とが好ましい。本発明の膜形成用組成物の全固形分濃度 は、好ましくは、2~30重量%であり、使用目的に応 じて適宜調整される。組成物の全固形分濃度が2~30 重量%であると、塗膜の膜厚が適当な範囲となり、保存 安定性もより優れるものである。

【0027】本発明の組成物を、シリコンウエハ、Si

※は、スピンコート、浸漬法、ロールコート法、スプレー 法などの塗装手段が用いられる。

【0028】この際の膜厚は、乾燥膜厚として、1回途 りで厚さ0.05~1.5 m 程度、2回塗りでは厚さ O. 1~3 µm程度の塗膜を形成することができる。そ の後、常温で乾燥するか、あるいは80~600℃程度 の温度で、通常、5~240分程度加熱して乾燥するこ とにより、ガラス質または巨大高分子の絶縁膜を形成す ることができる。この際の加熱方法としては、ホットプ 来、加熱雰囲気としては、大気下、窒素雰囲気、アルゴ ン雰囲気、真空下、酸素濃度をコントロールした減圧下 などで行うことができる。

【0029】このようにして得られる層間絶縁膜は、絶 緑性に優れ、塗布膜の均一性、比誘電率特性、塗膜の耐 クラック性、塗膜の表面硬度に優れることから、LS I、システムLシ、DRAM、SDRAM、RDRA M、D-RDRAMなどの半導体素子用層間絶縁膜、半 導体素子の表面コート膜などの保護膜、多層レジストを 〇2 ウエハ、SiNウエハなどの基材に塗布する際に※50 用いた半導体作製工程の中間層、多層配線基板の層間絶

縁膜、液晶表示素子用の保護膜や絶縁膜などの用途に有 用である。

[0030]

【実施例】以下、実施例を挙げて、本発明をさらに具体 的に説明する。なお、実施例および比較例中の部および %は、特記しない限り、それぞれ重量部および重量%で あることを示している。また、実施例中における膜形成 用組成物の評価は、次のようにして測定したものであ る。

【0031】重量平均分子量 (Mw)

下記条件によるゲルパーミエーションクロマトグラフィ ー (GPC) 法により測定した。

試料:テトラヒドロフランを溶媒として使用し、加水分 解縮合物1gを、100ccのテトラヒドロフランに溶 解して調製した。

標準ポリスチレン: 米国プレッシャーケミカル社製の標 準ポリスチレンを使用した。

装置: 米国ウオーターズ社製の高温高速ゲル浸透クロマ トグラム (モデル150-C ALC/GPC)

カラム:昭和電工 (株) 製のSHODEX A-80M 20 厚))÷(保存前の膜厚)×100 (長さ50cm)

測定温度:40℃

流速:1cc/分

【0032】機械的強度(弾性率)

8インチシリコンウエハ上に、スピンコート法を用いて 組成物試料を塗布し、ホットプレート上で90℃で3分 間、窒素雰囲気200℃で3分間基板を乾燥し、さらに 400℃の減圧 (50mTorr) の真空オーブンで6 0分基板を焼成した。得られた膜の弾性率は、ナノイン デンターXP (ナノインスツルメント社製) を用いて、 連続剛性測定法により測定した。

耐クラック性

8インチシリコンウエハ上に、スピンコート法を用いて 組成物試料を塗布した。この際、硬化後の塗膜の膜厚が 1.3μmになるように膜厚を調整した。この塗膜を、 ホットプレート上で90℃で3分間、窒素雰囲気200 ℃で3分間基板を乾燥し、さらに400℃の減圧(50 mTorr)の真空オーブンで60分基板を焼成した。 得られた塗膜の一部をナイフで傷を付け、純水中に2時 間浸漬した。塗膜中のナイフの傷跡を顕微鏡で観察し、 以下の基準で評価した。

: クラックの伝搬認められない。

×:クラックの伝搬認められる。

【0033】比誘電率

8インチシリコンウエハ上に、スピンコート法を用いて 組成物試料を塗布し、ホットプレート上で90℃で3分 間、窒素雰囲気200℃で3分間基板を乾燥し、さらに 400°Cの減圧 (50mTorr) の真空オーブンで6 0分基板を焼成した。得られた基板上にアルミニウムを 蒸着し、比誘電率評価用基板を作製した。比誘電率は、 横川・ヒューレットパッカード (株)製のHP1645 1B電極およびHP4284AプレシジョンLCRメー ター用いて、10kHzにおける容量値から算出した。 【0034】溶液の保存安定性

18

30℃で30日保存した膜形成用組成物を、8インチシ リコンウエハ上に、スピンコーターを用いて、回転数 2,500 rpm、30秒の条件で以て塗布した。その 後、90℃の温度に保持したホットプレートを用いて、 膜形成用組成物を塗布したシリコンウエハを3分間加熱 10 し、有機溶媒を飛散させた。次いで、窒素雰囲気200 ℃の温度に保持したホットプレートを用いて、膜形成用 組成物を塗布したシリコンウエハを3分間加熱し、シリ コンウエハ上に塗膜を形成させた。このようにして得ら れた塗膜の膜厚を、光学式膜厚計 (Rudolph T echnologies社製、Spectra Las er200)を用いて塗膜面内で50点測定した。得ら れた膜厚の膜厚を測定し、下式により求めた膜厚増加率 により、保存安定性を評価した。

膜厚増加率(%)=((保存後の膜厚)-(保存前の膜

〇: 膜厚增加率5%以下

×: 膜厚増加率5%超える

【0035】合成例1

石英製セパラブルフラスコ中で、メチルトリメトキシシ ラン205.50gとテトラメトキシシラン85.51 gを、プロピレングリコールモノエチルエーテル426 gに溶解させたのち、スリーワンモーターで攪拌させ、 溶液温度60℃に安定させた。次に、無水マレイン酸 0.013gを溶解させたイオン交換水182gを1時 間かけて溶液に添加した。その後、60℃で2時間反応 させたのち、反応液を室温まで冷却した。50℃で反応 液からメタノールを含む溶液を360gエバポレーショ ンで除去し、反応液のを得た。なお、メチルトリメトキ シシランおよびテトラメトキシシランのアルコキシル基 1モルに対して無水マレイン酸は0.000020モ ル、水は1.49モルに相当する。このようにして得ら れた縮合物等の重量平均分子量は、1,000であっ た。

【0036】合成例2

石英製セパラブルフラスコ中で、メチルトリメトキシシ ラン205.50gとテトラメトキシシラン85.51 gを、プロピレングリコールモノメチルエーテル426 gに溶解させたのち、スリーワンモーターで攪拌させ、 溶液温度60℃に安定させた。次に、無水マレイン酸 63gを溶解させたイオン交換水182gを1時間 かけて溶液に添加した。その後、60℃で2時間反応さ せたのち、反応液を室温まで冷却した。50℃で反応液 からメタノールを含む溶液を360gエバポレーション で除去し、反応液②を得た。なお、メチルトリメトキシ 50 シランおよびテトラメトキシシランのアルコキシル基1

モルに対して無水マレイン酸は0.00095モル、水は1.49モルに相当する。このようにして得られた縮合物等の重量平均分子量は、1,300であった。

【0037】合成例3

合成例1において、イオン交換水の使用量を109gとした以外は合成例1と同様にして、反応液②を得た。なお、メチルトリメトキシシランおよびテトラメトキシシランのアルコキシル基1モルに対して無水マレイン酸は0.000020モル、水は0.89モルに相当する。このようにして得られた縮合物等の重量平均分子量は、970であった。

【0038】合成例4

合成例1において、イオン交換水の使用量を291gとした以外は合成例1と同様にして、反応液②を得た。なお、メチルトリメトキシシランおよびテトラメトキシシランのアルコキシル基1モルに対して無水マレイン酸は0.000020モル、水は2.38モルに相当する。このようにして得られた縮合物等の重量平均分子量は、1,350であった。

【0039】比較合成例1

合成例1において、無水マレイン酸の使用量を0.002gとした以外は合成例1と同様にして、反応液のを得た。なお、メチルトリメトキシシランおよびテトラメトキシシランのアルコキシル基1モルに対して無水マレイン酸は0.000030モル、水は1.49モルに相当する。このようにして得られた縮合物等の重量平均分子量は、550であった。

比較合成例2

合成例1において、無水マレイン酸の使用量を4.2gとした以外は合成例1と同様にして、反応液のを得た。なお、メチルトリメトキシシランおよびテトラメトキシシランのアルコキシル基1モルに対して無水マレイン酸は0.006モル、水は1.49モルに相当する。この

ようにして得られた縮合物等の重量平均分子量は、2,200であった。

2.0

比較合成例3

合成例1において、イオン交換水の使用量を84gとした以外は合成例1と同様にして、反応液**の**を得た。なお、メチルトリメトキシシランおよびテトラメトキシシランのアルコキシル基1モルに対して無水マレイン酸は0.000020モル、水は0.69モルに相当する。このようにして得られた縮合物等の重量平均分子量は、800であった。

比較合成例4

合成例1において、イオン交換水の使用量を360gとした以外は合成例1と同様にして、反応液のを得た。なお、メチルトリメトキシシランおよびテトラメトキシシランのアルコキシル基1モルに対して無水マレイン酸は0.000020モル、水は2.95モルに相当する。このようにして得られた縮合物等の重量平均分子量は、1,470であった。

【0040】実施例1

20 合成例1で得られた反応液の50gにNBX-15 0.005gを溶解し、0.2μm孔径のテフロン製フィルターでろ過を行い本発明の膜形成用組成物を得た。 得られた組成物をスピンコート法でシリコンウエハ上に 塗布した。得られた塗膜の弾性率は6.3GPaと機械 的強度に優れており、水浸漬後もクラックの伝搬は認め られなかった。塗膜の比誘電率を評価したところ、2. 78と低い比誘電率を示した。また、溶液保存時の膜厚 増加率は4.2%と優れた保存安定性を示した。

【0041】実施例2~6

表1に示す組成で膜形成用組成物を作製し、実施例1と 同様に評価を行った。評価結果を表1に併せて示す。 【0042】

【表1】

,		1					22
実	施	反応被	添加剤	弹性率	耐クラック	比誘	膜厚增加
例	_			(GPa)	性	電率	率(%)
1		反応被 ①50g	NBX-15 0. 005g	6.9	0	2.78	4.2
2		反応被 ②50g	* りまキシブ ロヒ レン-* りまキシエチレンプ	6.2	0	2.64	4.1
			ロックコは、リマー(ニューホ・ール) PE61[HO-PEO+PPOn- PEO+OH 相当])1.25g				
3		反応被	SH28PA 0.002g, ポリオネシエチレン-	3.8	0	2.28	4.7
		③50g	ま。引持シブロピ、ひいま。引持シエチレンプ ロッタコは。 リマー(ニューキ。 ール PE61[HO-PEO+PPO++ PEO+OH 相当]3.75g				
4		反応被	SH28PA 0.002g,平均分子量	3.6	Ö	2.19	4.5
		Q50 g	3,000 のまりプロピレンオキサイト。 3.75g				
5		反応被 @50g	無し	6.8	0	2.77	4.8

NBX-15 フッ素系界面活性剤 SH28PA シリコーン系界面活性剤

【0043】比較例1

比較合成例1で得られた反応液ののみを使用した以外 は、実施例1と同様にして評価を行った。溶液塗布時に したところ、クラックの伝搬が認められた。

比較例2

比較合成例2で得られた反応液ののみを使用した以外 は、実施例1と同様にして評価を行った。得られた塗膜 を水浸漬したところ、クラックの伝搬が認められた。 比較例3

比較合成例3で得られた反応液像のみを使用した以外 は、実施例1と同様にして評価を行った。得られた塗膜* *を水浸漬したところ、クラックの伝搬が認めら、溶液を 保存したところ膜厚増加率が6.4%であった。

比較例4

比較合成例4で得られた反応液ののみを使用した以外 は、実施例1と同様にして評価を行った。溶液を保存し ピンホール状の欠陥が認められ、得られた塗膜を水浸漬 30 たところ膜厚増加率が8.3%であり、溶液に濁りが認 められた。

[0044]

【発明の効果】本発明によれば、特定量の有機酸と水を 用いてアルコキシシランの加水分解および/またはその 縮合を行うことで、塗膜の機械的特性やクラック耐性、 溶液の保存安定性に優れ、低い比誘電率を示す膜形成用 組成物 (層間絶縁膜用材料)を提供することが可能であ る。

フロントページの続き

(72)発明者 西川 通則

東京都中央区築地二丁目11番24号ジェイエ スアール株式会社内

(72)発明者 山田 欣司

東京都中央区築地二丁目11番24号ジェイエ スアール株式会社内

Fターム(参考) 4J038 DF012 DF022 DF042 DL021 DL051 DL071 DL081 DL152

GA07 GA12 JA26 JA37 JA38

JA39 JA40 JA41 JA56 JA57

JA58 JC13 JC25 KA06 KA09

LA02 MA07 MA09 NA11 NA21

NA26

5F058 AA10 AC03 AF04 AG01 AH01

AH02